

Сведения об официальном оппоненте

Игнатьев Иван Владимирович

Электронная почта: i.ignatiev@spbu.ru

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Специальность 01.04.10 – физика полупроводников

Место работы

Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Наименование структурного подразделения: физический факультет, кафедра физики твердого тела

Должность: профессор

Тип организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 198504, Санкт-Петербург, ул. Ульяновская, 1

Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1. Kurdyubov A.S. et al. Photoinduced Absorption of THz Radiation in Semi-Insulating GaAs Crystal // Phys. Solid St. — 2017. — V. 59 — P. 1298. DOI: 10.1134/S1063783417070125
2. Bodnar S. Yu. et al. Exciton mass increase in a GaAs/AlGaAs quantum well in a transverse magnetic field // Phys. Rev. B — 2017. — V. 95 — P. 195311. DOI: 10.1103/PhysRevB.95.195311
3. Grigoryev P. S. et al. Exciton-light coupling in (In,Ga)As/GaAs quantum wells in longitudinal magnetic field // Phys. Rev. B — 2017. — V. 96 — P. 155404. DOI: 10.1103/PhysRevB.96.155404
4. Kurdyubov A.S. et al. Impurity-activated photoinduced modulation of terahertz waves in GaAs crystal // AIP Advances — 2017. — V. 7 — P. 115222. DOI: 10.1063/1.4995358
5. Trifonov A.V. et al. Nanosecond Spin Coherence Time of Nonradiative Excitons in GaAs/AlGaAs Quantum Wells // Phys. Rev. Lett. — 2019. — V. 122 — P. 147401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.147401
6. Khramtsov E.S. et al. Exciton spectroscopy of optical reflection from wide quantum wells // Phys. Rev. B — 2019. — V. 99 — P. 035431. DOI: 10.1103/PhysRevB.99.035431
7. Shapochkin P. Yu et al. Excitonic probe for quantum-state engineering by MBE technology // Phys. Rev. Applied — 2019. — V. 12, P. 034034. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.034034
8. Trifonov A.V. et al. On the Suppression of Electron-Hole Exchange Interaction in a Reservoir of Nonradiative Excitons // Semiconductors — 2019. — V. 53 — P. 1170. DOI: 10.1134/S1063782619090239
9. Loginov D.R. et al. Exciton-polariton interference controlled by electric field // Phys. Rev. Research — 2020. — V. 2 — P. 033510. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.033510
10. Kurdyubov A. S. et al. Optical Control of a Dark Exciton Reservoir // Phys. Rev. B — 2021. — V. 104 — P. 035414. DOI: 10.1103/PhysRevB.104.035414